

İLERİ ANALOG TMDEVRE TASARIMI

dev 4 (19. 3. 2003)

Aktif devre uygulamalarında kullanılmak zere bir DO-OTA (dual ıkıřlı OTA) devresi tasarlanacaktır. Devre $\pm 2.5V$ 'luk simetrik kaynakla beslenecektir. $I_{SS} \leq 100\mu A$ 'lik kutuplama akımında (st sınır $100\mu A$) eęimlerin $g_m = 150\mu A/V$ olması istenmektedir.

Yukarıda belirtilen alıřma noktasında

- Eęimin band geniřlięi $f_{3dB} > 30$ MHz,
- Giriř iřaretinin lineer deęiřim aralıęı

$$-1.2V \leq V_{IN} \leq 1.2V$$

- ıkıř direnci,

$$R_{O+}, R_{O-} > 10 M\Omega$$

olacaktır.

a- Devreyi $0.5 \mu m$ CMOS teknolojisini kullanarak tasarlayınız, tranzistorların boyutlarını belirleyiniz.

SPICE benzetim programı yardımıyla devrenin

b- dc akım geiř karakteristięini ıkartınız; (kutuplama akımı parametre olarak alınacaktır),

b- dc gerilim geiř karakteristięini ıkartınız; (kutuplama akımı parametre olarak alınacaktır),

c- g_{m1} ve g_{m2} geiř iletkenliklerinin I_{SS} kutuplama akımı ile deęiřimlerini (kutuplama akımı baęımsız deęiřken olarak alınacaktır, $g_{m1} = g_{m1}(I_{SS})$, $g_{m2} = g_{m2}(I_{SS})$,

d- g_{m1} ve g_{m2} geiř iletkenliklerinin frekansla deęiřimini (kutuplama akımı parametre olarak alınacaktır),

e- Z_{O+} ve Z_{O-} ıkıř empedanslarının frekansla deęiřimini (kutuplama akımı parametre olarak alınacaktır), her kutuplama akımı iin ıkıř direncini ve ıkıř kapasitesini belirleyiniz,

Elde ettięiniz sonuları yorumlayınız, ngrdęnz hedeflere ulařıp ulařamadıęınızı arařtırınız.